

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Лагов Петр Борисович
2	Дата рождения (полная)	27.06.1973
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук (специальность 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент (по кафедре)
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	111250, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 russianspacesystems.ru contact@spacecorp.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
	Ведомственная принадлежность организации	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
	Тип организации	Акционерное общество
	Наименование подразделения	Научный центр сертификации элементов и оборудования НЦ СЭО
	Должность	Начальник отдела
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polyakov A. Y., Schemerov I. V., Vasilev A. A., Romanov A. A., Lagov P. B., Miakonkikh A. V., Chernykh A. V., Romanteeva E. P., Chernykh S. V., Rabinovich O. I., Pearton S. J. Trap states and hydrogenation of implanted Si in semi-insulating Ga₂O₃ (Fe) // Journal of vacuum science and technology A. – 2025. – Vol. 43. – № 3. DOI 10.1116/6.0004463 2. Schemerov I. V., Lagov P. B., Kobleva S. P., Kirilov V. D., Drenin A. S., Mescheryakov A. A. Optimization of the transient characteristics of the rectifiers under high-energy electron irradiation // Instruments and experimental techniques. – 2024. – Vol. 67. – № 3. – P. 587–592. DOI 10.1134/S0020441224700866 3. Щемеров И. В., Лагов П. Б., Кобелева С. П., Кирилов В. Д., Дренин А. С., Мещеряков А. А. Определение пределов оптимизации переходных характеристик выпрямительных диодов при облучении высокоэнергетическими электронами // Приборы и техника эксперимента. – 2024. – № 3. – С. 139–144. DOI 10.31857/S0032816224030197 4. Касимова В. М., Козлова Н. С., Забелина Е. В., Бузанов О. А., Лагов П. Б., Павлов Ю. С., Кулевой Т. В., Столбунов В. С. Влияние облучения протонами на оптические свойства и дефектообразование в кристаллах Gd₃Al_xGa_{5-x}O₁₂ (x = 2, 3) // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2024. – № 1. – С. 71–76. DOI 10.31857/S1028096024010109 5. Aslanov L. A., Zaitsev V. B., Zakharov V. N., Kudryavtsev I. K., Senyavin V. M., Lagov P. B., Romanteeva E. P. Nanosilicon stabilized with ligands: Effect of high-energy proton beam on luminescent properties // Surface and Interface Analysis. – 2024. DOI 10.1002/sia.7354 	

	<p>6. Kasimova V.M., Kozlova N.S., Zabelina E.V., Buzanov O.A., Lagov P.B., Pavlov YU.S., Kulevoy T.V., Stolbunov V.S. Effect of proton irradiation on the optical properties and defect formation in $Gd_3Al_xGa_{5-x}O_{12}$ ($x = 2, 3$) crystals // Journal of surface investigation: X-Ray, synchrotron and neutron techniques. – 2024. – Vol. 18. – № 1. – P. 58–62. DOI 10.1134/S1027451024010105</p> <p>7. Polyakov A.Y., Saranin D.S., Shechemerov I.V., Vasilev A.A., Romanov A.A., Kochkova A.I., Gostischev P., Chernykh A.V., Alexanyan L.A., Matros N.R., Lagov P.B., Doroshkevich A.S., Isayev R.SH., Pavlov YU.S., Kislyuk A.M., Yakimov E.B., Pearton S.J. Proton irradiation Of Ga_2O_3 Schottky diodes and NiO/Ga_2O_3 heterojunctions// Scientific Reports. – 2024. – Vol. 24. – № 1. – P. 27936 DOI 10.1038/s41598-024-78531-y</p> <p>8. Запетляев В.М., Жуков А.А., Лагов П.Б., Якухин С.Д. Экспериментальная оценка радиационной стойкости СВЧ-фильтров космического назначения на основе высокоомного кремния // Успехи прикладной физики. – 2024. – Т. 12. – № 6. – С. 547–555. DOI 10.51368/2307-4469-2024-12-6-547-555</p> <p>9. Лагов П.Б., Мещеряков А.А., Дренин А.С., Павлов Ю.С., Ромانتеева Е.П. Исследование технологических режимов радиационно-термической обработки на основе облучения высокоэнергетическими электронами для повышения радиационной стойкости субмикронных микросхем // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2024. – Т. 11. – № 1. – С 95–102. ссылка: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67852131</p> <p>10. Мещеряков А.А., Дренин А.С., Сирбаев Р.Ю., Селин Д.С., Лагов П.Б., Павлов Ю.С., Иванов Е.М., Американов Д.А., Кулевой Т.В.5, Столбунов В.С., Романтеева Е.П., Петров К.К. Повышение радиационной стойкости микроконтроллеров к воздействию высокоэнергетичных протонов с помощью радиационно-термической обработки // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2024. – Т. 11. – № 4. – С. 85–93. ссылка: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=79604138</p> <p>11. Щемеров И.В., Поляков А.Я., Лагов П.Б., Кобелева С.П., Кочкова А.И., Куланчиков Ю.О., Дорошкевич А.С., Кирилов В.Д. Влияние центров захвата, внесенных облучением протонами с энергией 1 МэВ, на время восстановления обратного тока в диодах Шоттки на основе Ga_2O_3 // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2023. – Т. 89. – № 7. – С 25–33. DOI 10.26896/1028-6861-2023-89-7-25-33</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты